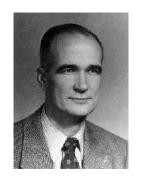


§ 1.3 晶体管 (三极管)



- (a) 金属圆壳封装三极管
- (b) 塑料封装三极管
- (c) 大功率三极管



威廉·肖克利, 美国科学家 晶体管之父, 1956年诺贝尔物理学奖

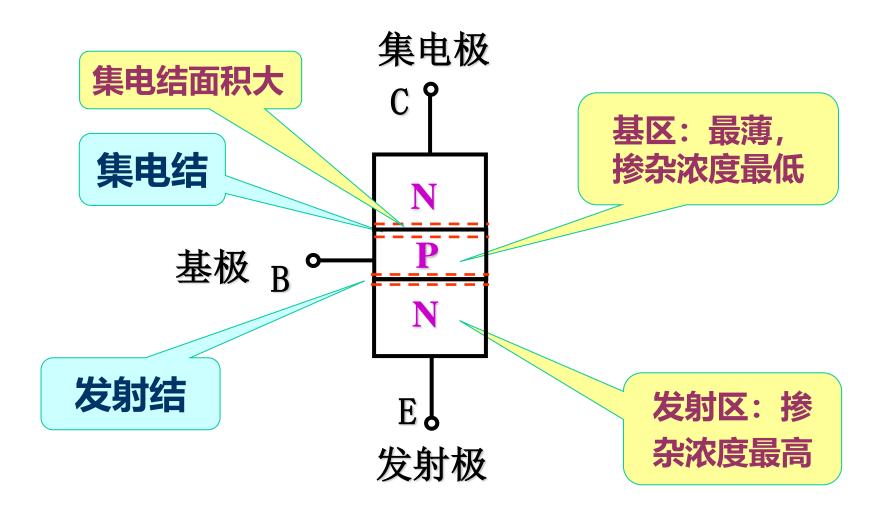


视频资料

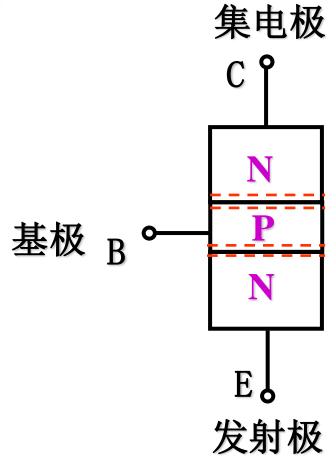
- ▶ 晶体管制造工艺 0:30-2:20
- **▶晶体管放大条件和原理** 2:20---4:50
- > 电流分配关系 * 4:50 ---8:50
- ➢ 温度对电流的影响 * 8:50----

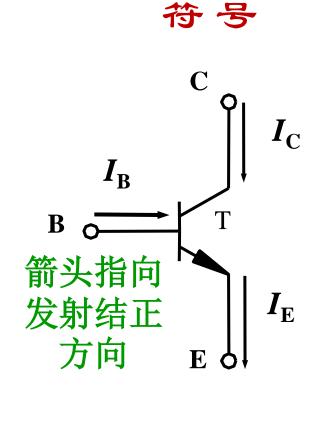


双极型晶体三极管结构特点





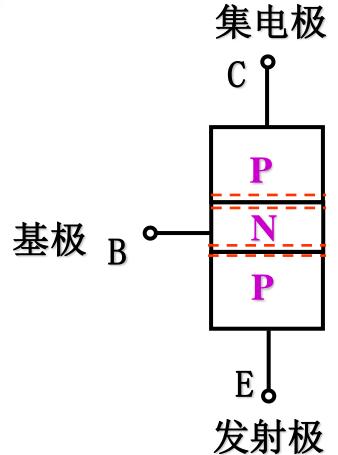




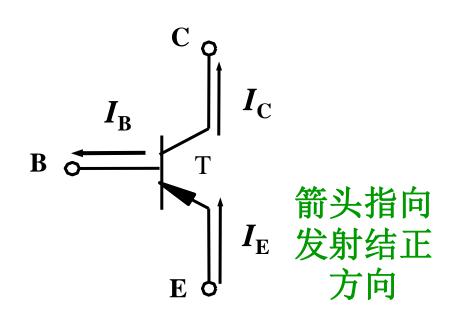
NPN型晶体管

Transistor









PNP型晶体管



晶体管电流分配和放大关系

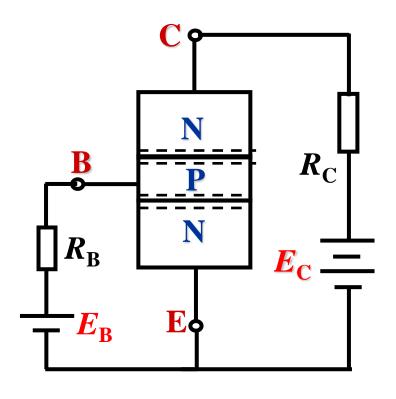
> 放大的外部条件:发射结正偏、集电结反偏

从电位的角度看

NPN

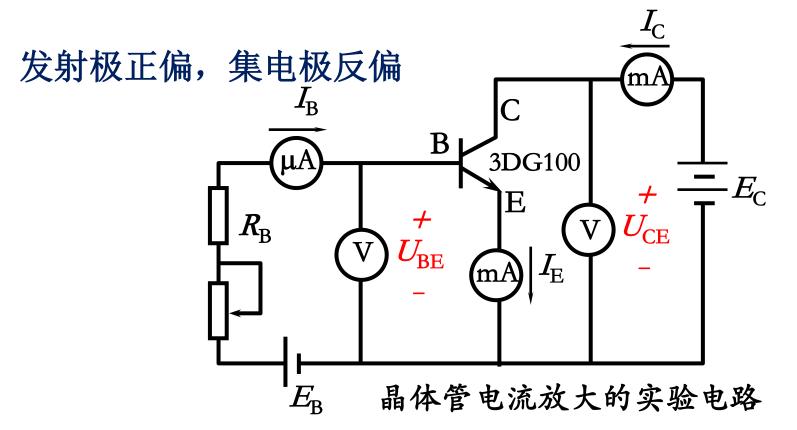
发射结正偏 $V_{\rm B} > V_{\rm E}$ 集电结反偏 $V_{\rm C} > V_{\rm B}$ 集电极电位最高 PNP

发射结正偏 $V_{\rm B} < V_{\rm E}$ 集电结反偏 $V_{\rm C} < V_{\rm B}$ 集电极电位最低

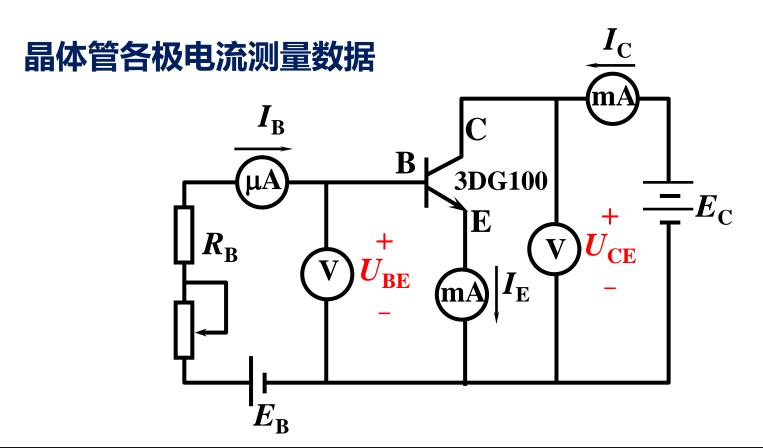




从工程实践角度探索三极管各极电流关系



改变可变电阻 R_B ,使基极电流 I_B 发生变化,观察集电极电流 I_C 和发射极电流 I_E 的变化



$I_{\rm B}({\rm mA})$	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10
$I_{\rm C}({ m mA})$	<0.001	0.70	1.50	2.30	3.10	3.95
$I_{\rm E}({ m mA})$	<0.001	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05



数据分析:

$I_{\rm B}({ m mA})$	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10
$I_{\rm C}({ m mA})$	<0.001	0.70	1.50	2.30	3.10	3.95
$I_{\rm E}({ m mA})$	<0.001	0.72	1.54	2.36	3.18	4.05

•
$$I_E = I_B + I_C$$
 符合基尔霍夫定律

•
$$I_{\rm C} >> I_{\rm B}$$
, $I_{\rm C} \approx I_{\rm E}$

 $\frac{I_C}{I}$ (35, 37.5, 38.3, 38.7, 39.5)

$$\bullet \ \Delta I_{\rm C} >> \Delta I_{\rm B} \boxed{\frac{\Delta I_{\rm C}}{\Delta I_{\rm B}}}$$

(40, 40, 40, 42.5)

基极电流的微小变化能引起集电极电流较大的变化!

放大实质:

晶体管的电流放大作用

用一个微小电流的变化去控制一个较大电流的变化

晶体管是电流控制电流的器件



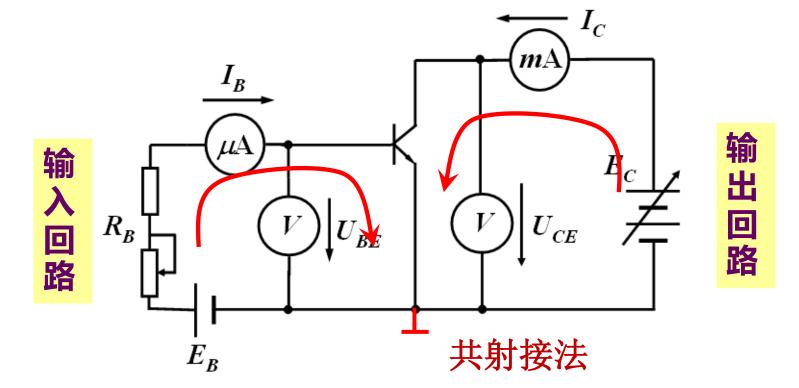
§ 1.3.2 晶体管的特性曲线——只能实测

输入特性曲线

$$I_{\rm B} = f(U_{\rm BE})|_{U_{\rm CE} = \%}$$

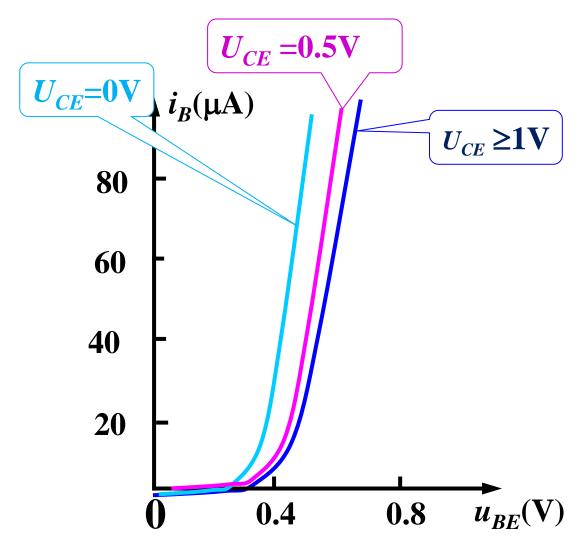
输出特性曲线

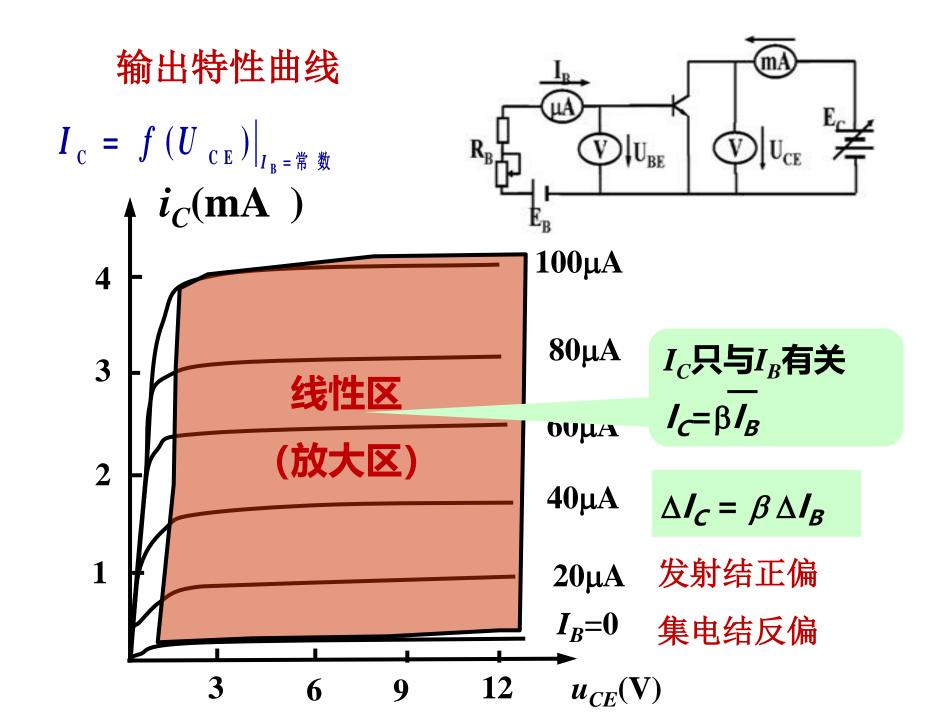
$$I_{C} = f(U_{CE})|_{I_{R} = \% \, \text{\%}}$$

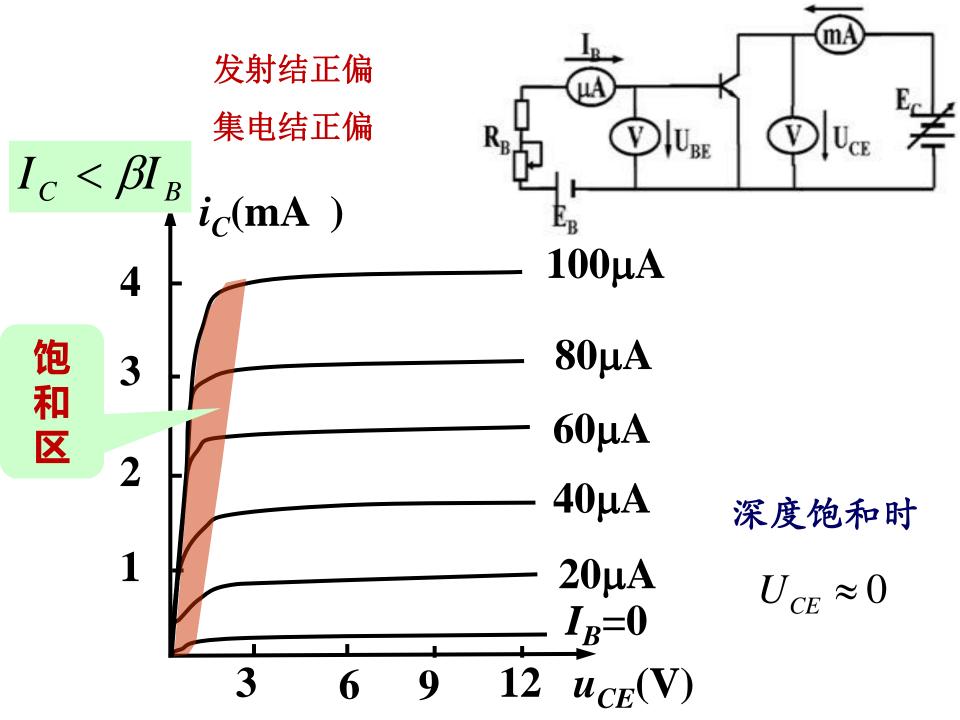




输入特性曲线
$$I_{B} = f(U_{BE})|_{U_{CE} = \% \text{ } \%}$$

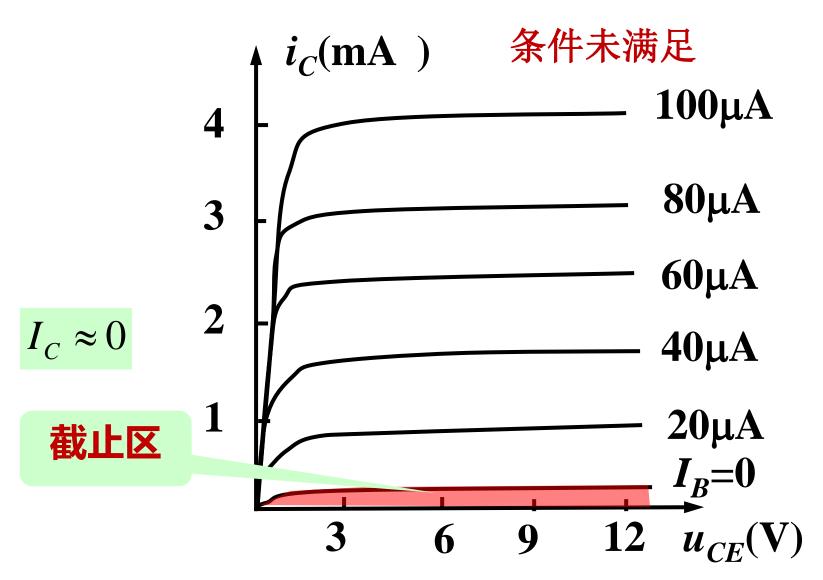








发射结正偏



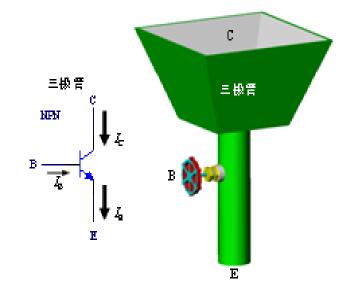


放大电路三个工作区域的特点

(1) 放大区:发射结正偏,集电结反偏

(2) 饱和区:发射结正偏,集电结正偏

(3) 截止区: U_{BE} < 死区电压

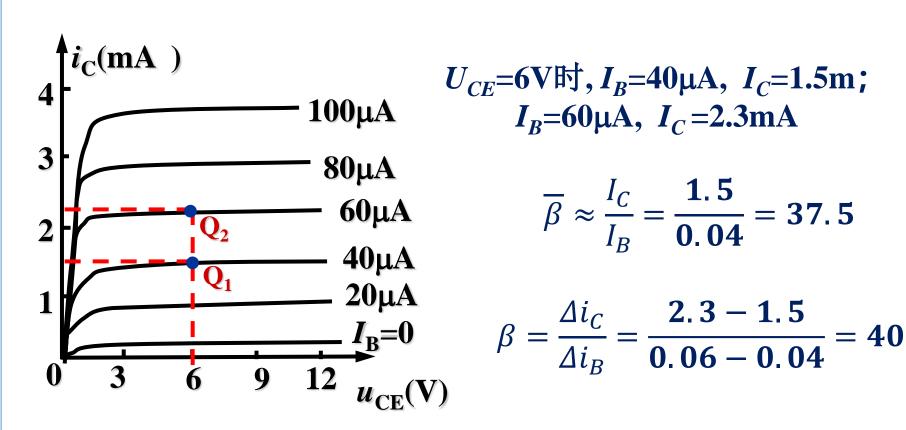




共射直流电流放大倍数: $\overline{\beta} \approx \frac{I_C}{I_B}$

共射交流电流放大倍数: $\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$

一般计算中近似处理: $\beta = \overline{\beta}$



例: β = 50, U_{SC} = 12V R_B = 70kΩ, R_C = 6kΩ 当 U_{SB} = -2V, 2V, 5V 时, 晶体管处于何种工作状态?

解1: 当 U_{SB}=-2V 时:

$$I_B$$
=0 , I_C =0
截止

当 U_{SB} =2V时:

$$I_B = \frac{U_{SB} - U_{BE}}{R_B} = \frac{2 - 0.7}{70} = 19\mu A$$

假定在放大区 $I_C = \beta I_B = 50*19 = 950 \,\mu\,\text{A} = 0.95 \,\text{m}\,\text{A}$ $U_{CE} = U_{SC} - I_C R_C = 12 - 6*0.95 \approx 6V$ $U_{CE} > U_{BE} \quad 假定成立 \qquad 放大$



当 $U_{SB} = 5V$ 时:

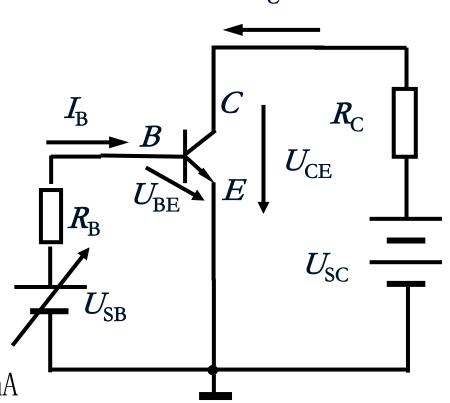
$$I_{\rm B} = \frac{5 - 0.7}{70} = 62\mu \text{A}$$

假定在放大区

$$I_{\rm C} = \beta I_{\rm R} = 50 * 62 = 3.1 \text{mA}$$

$$U_{\text{CE}} = U_{\text{SC}} - I_{\text{C}}R_{\text{C}} = 12 - 6 * 3.1 < 0V$$

$$U_{\rm CE}$$
 $< U_{\rm BE}$ 假定不成立 饱和



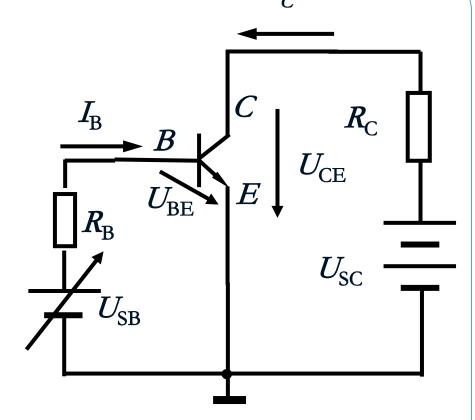


解2: 先算I_C 最大值

$$I_{\text{Cmax}} \approx \frac{U_{\text{SC}}}{R_{\text{C}}} = \frac{12}{6} = 2\text{mA}$$

算临界饱和时电流IB

$$I_{\rm B}^{'} \approx \frac{2\text{mA}}{50} = 40\mu\text{A}$$

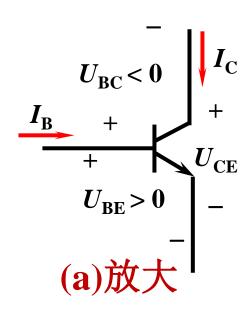


当
$$U_{SB}$$
=2V时 $I_{B} = 19\mu A < 40\mu A$ 放大

当
$$U_{SB} = 5V$$
时 $I_B = 62\mu A > 40\mu A$ 饱和

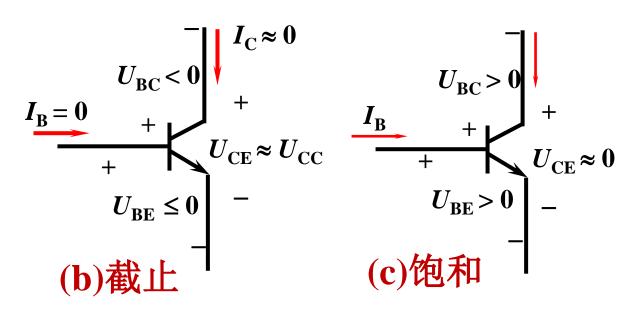


晶体管三种工作状态



$$I_{\mathrm{C}} = \beta I_{\mathrm{B}}$$
 且 $\Delta I_{\mathrm{C}} = \beta \Delta I_{\mathrm{B}}$

模拟电路



I_C ≈0 发射极和集电极之间如同开关断开,电阻很大。

U_{CE} ≈0 发射极和集 电极之间如 同开关接通, 电阻很小

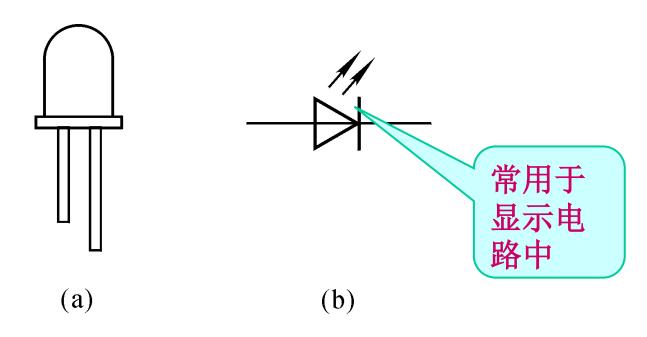
数字电路



补充: 光电器件

发光二极管

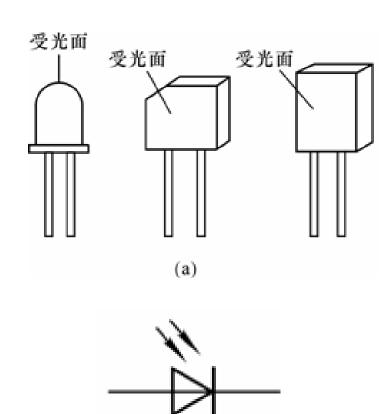
加上正向电压并有足够大的正向电流时, 能发出一定波长范围的光。



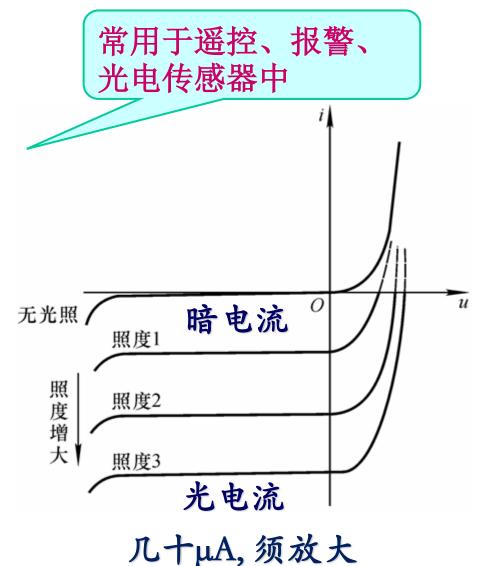
Light-Emitting Diode



光电二极管



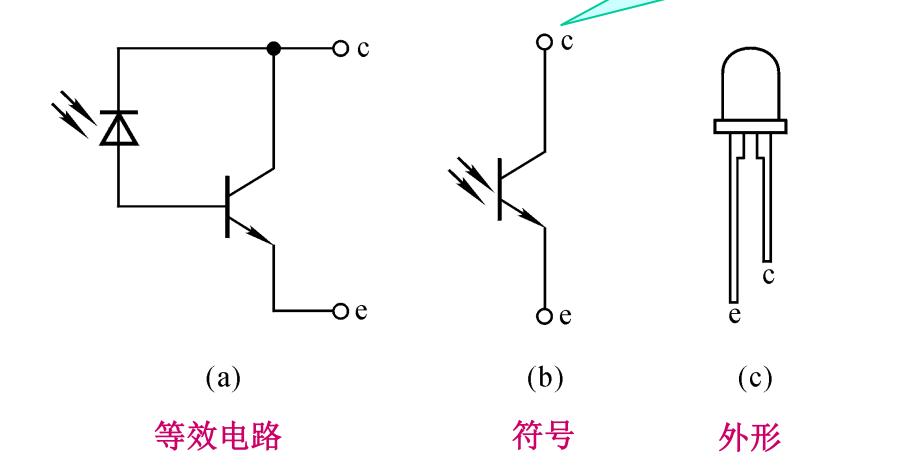
工作在反向电压作用下





光电晶体管

由光照强度控制集电极电流大小





第一章作业

- •1.1 图 (a) 注:第一个图;
- **1.3**;
- •1.4 含二极管电路分析
- •<u>1.11;</u>
- •1.12 三极管应用电路分析

按钮:按下接通,松手后自动弹起

继电器:由电磁铁+线圈(图中KA方框)和触点(图中KA触点)两部分组成。

当线圈上加上额定电压时,常开触点闭合,否则常开触点断开